PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-149251

(43)Date of publication of application: 30.05.2000

(51)Int.CI.

G11B 5/84 G11B 7/26

(21)Application number: 10-324728

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing: 16.11.1998

(72)Inventor: TODA HISASHI

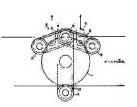
(54) CLEANING DEVICE FOR DISK SUBSTRATE AND CLEANING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stabilize the rotation of a substrate and to enable cleaning to be performed in a high speed rotation by providing three or more driving rollers supporting and rotating a disk substrate when cleaning is performed supporting and rotating a disk

substrate.

SOLUTION: The outer periphery part of a disk substrate 1 is supported by movable driving rollers 2, 3, and a fixed driving roller 4 between them, and supported in the vertical state. Rotary power is given to the disk substrate 1 by these three driving rollers and the disk 1 is rotated, and cleaning is performed with a scrubbing roll and the like. These three driving rollers 2, 3, 4 are rotated at constant speed through one driving shaft from a drive source and three belts 8, 9, 10 or a gear. The disk 1 is rotated by three rollers at the time of cleaning. at the time of loading a disk and unloading a disk after finish of cleaning, two movable driving rollers 2, 3 at the upper part are moved to the upper side by moving roller



moving members 6, 7 to the upper side, and supporting the disk substrate 1 is released without moving the roller 4.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-149251

(P2000-149251A) (43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

| (51) Int.Cl.7 | | 徽別記号 | FI | | | m and 10 (decide) | |
|---------------|------|-------------|------|------|-----|-------------------------|--|
| G11B | 5/84 | ast Library | G11B | 5/84 | 7 | テーマコード(参考) 5 D 1 1 2 | |
| | 7/26 | 531 | GIID | 7/26 | 531 | 5D121 | |

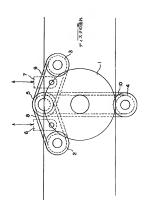
| | | 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁 |
|----------|-------------------------|------------------------------------|
| (21)出願番号 | 特願平10-324728 | (71)出職人 000005968 |
| (22)出顧日 | 平成10年11月16日(1998.11.16) | 三菱化学株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
| | | (72)発明者 戸田 久志 |
| | | 岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化气 |
| | | 株式会社水島事業所内 |
| | | (74)代理人 100103997 |
| | | 弁理士 長谷川 曉司 |
| | | Fターム(参考) 5D112 AAO2 AA24 GA08 KKO5 |
| | | 5D121 AA02 CG18 CG28 JJ03 |
| | | 5D121 AA02 GC18 GG28 JJ03 |
| | | |

(54) 【発明の名称】 ディスク基板の洗浄装置及び洗浄方法

(57)【要約】

【課題】 ディスク基板洗浄時の基板の回転を安定さ せ、さらに高速回転での洗浄を可能とし、洗浄力の向上 及び洗浄時間の短縮を測ることができる洗浄装置を提供 する。

【解決手段】 ディスク基板を支持し回転させながら洗 浄を行うディスク基板の洗浄装置であって、該ディスク 基板を支持し回転させる3以上の駆動ローラーを有する ディスク基板の洗浄装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ディスク基板を支持し回転させながら洗 浄を行うディスク基板の洗浄装置であって、該ディスク 基板を支持し回転させる3以上の駆動ローラーを有する ことを特徴とするディスク基板の洗浄装置。

【請求項2】 上記3以上の駆動ローラーは1以上の固定ローラーと1以上の可動ローラーとからなる請求項1に記載の洗浄装置。

【請求項3】 ディスク基板を支持し回転させながら洗 浄を行うディスク基板の洗浄方法であって、該ディスク 10 基板を3以上の駆動ローラーで支持し回転させながら洗 浄を行うことを特徴とするディスク基板の洗浄方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はディスク基板の洗浄 装置、更に詳しくは磁気ディスク、光記録ディスク等の 情報記録媒体の製造における基板の洗浄に適するディス ク基板の洗浄方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータ等の情報処理技術の 20 発達に中い、その外部記憶装置として磁気記録装置を光 記録試置、といて磁気ディスク等の磁気記録媒体や光 記録気がよった。ないでは、従来、アルミニウム合金基板にアルマイト処理やい、1 アリン・サール・イン・ 1 では、従来、アルミニウム合金基板にアルマイト処理やい、1 アリン・サール・イン・ 1 では、 1 では

[0003]また、光記録媒体として、プラスチック基板に反射層、磁性層および保護層を形成した後潤滑剤を 級を加した機能ダディスクが用いられているが、光磁気ディスクにおいても浮上量が3μm以下の浮上型ペッドあるいは再生ペッドが使用されている。記録あるいは再生ペッドの浮上量が小さくなると記録媒体表面の均一性は高い精疲が要求され、異物があるとペッドクラッシュが生じて破損に至るおそれがあり、また、ペッドクラッシュに至らないまでも、記録・再生のエラーの原因となる。

【0004】また、磁気ディスク等は、ディスク起動時 にヘッドがディスク面に固着したまま浮上しないという 付着現象が生たり、動作中にヘッドとディスクとが接 触して摩擦抵抗のため正常な回転が狙害される問題があ る。磁気ディスクにおいては特に、上述の高密度化(低 浮上量化)と並行して小型化も進められており、スピン ドル回転即のトッターも、サキャルなくかっている。ス ドル回転即のトッターも、サキャルなくかっている。ス の結果、モーターのトルクが不足し、起動時に磁気へッドが磁気ディスク面に困着したまま浮上しないという付 着現象が生ずるおそれがある。また動作中に磁気ヘッド と磁気ディスクとが接触して、摩擦抵抗のため正常な回 転が阻害されるおそれもある。

【0005】これらの現象の発生を防止する手段とし て、磁気ディスクの場合は、基板表面に微細な凹凸を形 成するテキスチャ加工と称する表面処理が行われてい る。かかるテキスチャ加工あるいは研磨の後には、バリ 状物あるいは塵埃の除去のために極めて高度な洗浄を必 要とする。図2に従来用いられているディスク基板洗浄 装置のディスク支持回転部の模式図を示す。ディスク基 板1は、その端部を、駆動ローラー12、駆動ローラー 13及び駆動部を持たないサポートローラー14の3つ のローラーにより支持されている。ディスク基板 1 は駆 動ローラー12及び駆動ローラー13により回転力を与 えられて回転し、図示しないスクラブロール等により洗 浄が行われる。洗浄終了後は、駆動ローラー12は図の 上方に移動し、駆動ローラー13及びサポートローラー 14は図の下方に移動し、ディスク基板1の支持を解除 する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、洗浄の向上及び洗浄時間の短縮等の要求が高まり、洗浄時のディスク基板の回転数が飛激に高まり、従来は200~300 г pm程度であったのが最近は1000 г pm程度であったのが最近は1000 г pm に達しつつかる。しかして、従来の洗浄装置は、ディスク基板を高速で回転させようとするとサポートローラー14がスリップしてしまいこれがディスク基板の幅かつ原因となり、ディスク基板の一部で十分な洗浄が行われないといった問題があった。本発明は、上記問題点に鑑み、ディスク基板洗浄時の基板の回転を定定させ、さらに高速回転での洗浄を可能とし、洗浄力の向上及び洗浄時間の短縮を捌ることを目的とする。

[0007]

「課題を解決するための手段」本発明は、かから課題を 解決するために既議検討を行った結果なされたもので、 その要旨はディスタ基板を実施し配転させなから洗浄を 行うディスク基板の洗浄装置であって、該ディスク基板 を支持し回転させる3以上の駆動ローラーを有すること を検討とす。ディスク基板の洗浄装置に存する。また 本発明の別の要旨は、ディスク基板を支持し回転させな がら洗浄を行うディスク基板の洗浄方法であって、該デ ィスク基板を3以上の駆動ローラーで支持し回転させな がら洗浄を行うごとを特徴とするディスク基板の洗浄方 法に存する。

[0008]

る。磁気ディスクにおいては特に、上述の高密度化(低 環チ上量化)と並行して小型化も進められており、スピン ディスク、相変化型光ディスク、DVD-ROM等の光 ドル回転用のモーターもますます小さくなっている。そ 50 記録媒体等の情報記録媒体用のディスク基数の光涂に道 用される。情報記録媒体用のディスク基板の洗浄は、ディスク基板の研路、テキスチャ加工、ポリッシュ加工の 後等に行うれる。 なお、本本別においてディスタ基板と は、記録媒体の基盤を形成する機材から機能層が積層さ れて製品に至るまでの各段階におけるものを含むものと する。

【0009】磁気記録媒体としては、一般に基板上に下 地層、磁性層および保護層が順次形成される。本発明に 使用される磁気記録媒体の非磁性基板としては、一般に アルミニウムまたはアルミニウム合金からなるアルミニ 10 ウム系金属を使用し、これを所定の厚さのディスク状基 板形状に加工した後、その表面が鏡面加工される。この 基板に非磁性金属、例えば、Ni-P合金、または、N i-Cu-P合金等を無電解メッキ処理等により積層 し、更にこれにテキスチャ加工した後、下地層、磁性 層、保護層等が積層されて磁気ディスクが形成される。 【0010】テキスチャ加工工程に至る前の基板の処理 工程としては、帯状のアルミニウム系金属薄板を基板形 状に裁断した後、角部を研削するチャンファリング工程 を得て、平滑研削するグラインディング工程、Ni-P 20 等のメッキ工程、表面を平滑化するポリッシュ工程が行 なわれ、その間に、前工程で発生した応力歪みを除去す るための焼成 (熱処理) 工程が行なわれる。

【0011】ポリッシュ加工は例えば、表面に遊離砥粒を付着してしみ込ませたポリッシュパッドの間に基板を はさみこみ、界面活性利水溶液等の研磨液を補給しなが らポリッシュ加工を行ない、通常2~5ヵm超度ポリッ シュしてその表面を平均表面相さRaが50オングストローム以下、望ましくは30オングストローム以下に鏡 面仕上げする。

【0012】また、テキスチャ加工としては例えば、2 500~6000 単程度のアルミナ価粒を担持した研酵 テープを用いるテープ研制まは、遊離転数を用いるス ラリー研制により、上記ポリッシュ加工を施した基板面 に、平均表面相さRaが20オングストローム以上、好 ましくは30~300オングストローム。ちらに好まし くは50~150オングストロームに形成された条痕の 交差する角度が好ましくは10~40°、更に好ましく は10~30°の範囲の激情をもしくは凹凸を構度よ く形成するものであり、基板表面にクロスパターンの条 板を形成することは、吸着物性が改善されるという点で 好ましい。

【0013】テキスチャ加工された基板は、下地層が形成される。基板上に形成する下地層は、従来公知の非極性下地層でよく、例えば、Cr、Ti、Ni等で形成することができる。なお、下地層のCrまたはTiは、通常、これらの結晶性を損なわない範囲において、例えば、数原子%の範囲でSi、V、Cu等を含有する合金であっても良い。本発明においては、特に、Cr系の下地層が好適である。下地層の段厚は、通常50~200

0 オングストロームの範囲である。

【0014】上記基板の下地層上に形成される磁性層 は、一般に、Co-Cr、Co-Ni、Co-Cr-X、Co-Ni-X、Co-W-X等で表わされるコバ ルト系合金薄膜層である。ここでXとしては、Li、S i, P, Ca, Ti, V, Cr, Ni, As, Y, Z r, Nb, Mo, Ru, Rh, Ag, Sb, Hf, T a, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, La, Ce, Pr、Nd、Pm、Sm、EuおよびBよりなる群より 選ばれた1種または2種以上の元素が用いられる。磁性 層は、通常、スパッタリング等の手段によって、基板の 下地層上に被着形成される。この磁性層の膜厚は、通常 100~1000オングストロームの範囲が好ましい。 【0015】保護層は、炭素膜、水素化カーボン膜、窒 素化カーボン膜、TiC、SiC等の炭化膜、SiN、 TiN等の窒化膜、SiO、Al₂O₃、ZrO等の酸化 物膜等によって構成され、通常、スパッタ法により形成 される。保護層としては、炭素膜、水素化カーボン膜お よび窒素化カーボン膜が特に好ましい。保護層が形成さ れた後ポリッシュ加工が施され洗浄された後潤滑剤が塗 布される。潤滑層の厚さは約15~50オングストロー ムの範囲が好ましい。また、潤滑層形成後に加熱処理を 施してもよい。加熱温度は50°C以上であるが、潤滑剤 の分解温度よりも低い温度で適宜選択すればよい。

【0016】 潤滑剤としてはフッ素系液体潤滑剤が好ましい。特には、末端または側側に水酸基を有し、分子骨格中にフルオロカーボン 荷移を有する化合物、例えば、パーフルオロカルボン酸・ステル、パーフルオロジカルボン酸・ステル、パーフルオロがのアル・カルボン酸・イフルオロアルキルエステル、ガーフルオロアルキルエステル、カルボン酸が一フルオロアルキルエステル、カルボン酸が一フルオロアルキルエステル、カルボン酸が一フルオロアルオロアルオロアルオロアルオロアルオロボリエーテルカルボン酸、パーフルオロボリエーテル、カルボン酸、パーフルオロボリエーテルカルボン酸、パーフルオロボリエーテルカルボン酸、パーフルオロボリエーテルカルボン酸、パーフルオロボリエーテルカルボン酸、パーフルオロボリエーテルアルコール、パーフルオロボリエーテルエステル等を用いることができる。

であっても良い。本発明においては、特に、Cr系の下 【0018】ピットおよびグループを設けたスタンパー 地層が好適である。下地層の膜厚は、通常50~200 50 をもとに、これら樹脂を用いて射出成形、射出圧縮成 形、放射線硬化などによりピット/グループを転写形成 して樹脂基板とする。ガラス、金属、セラミック等と異 なり、樹脂を用いることで、幅または長さが2μm以 下、続さが100nm以下の微細なピットやグループが 精密かつ安価に形成できる。基板の厚みは0.4~2m 和程度が一般的である。あまり薄すぎると、基板が自重 によりたわんで平面性が出にくくなるが、2mmを超え ると強度面では大差がなくなる。

【0019】基板上に形成する光記録層としては、各種のものを用いることができ、例えば光磁気記録像や相変10位型記録像。を乗型記録像が用いられる。また、層構成としても特に制限はなく、各種の層構成を採用することができる。光磁気記録層としては、例えばTbFe、TbFeCo、TbFeCo、TbFeCo、可ちCo、可分下bFeCo、可能の充土類と遷移金属との非晶質磁性層、MnBi、MnCuBi等の多結品重直能化層、Pt/Co多層膜等が用いられる、光磁気記録解性場層であっても良いし、オーバーライトやMSRを可能とするためにGdTbFe/TbFeのように2層以上の磁性層を重ねて用いても良い。

【0020】相変化型記録層としては、例えばGeSb Te%InSbTe, AgSbTe, AgInSbTe といった化合物が使用できる。好ましくは、 { (Sb₂ Te_1) - (GeTe), I_{17} Sb, (0, 2<x< 0.9、0≦y<0.1)合金、および該3元合金に1 0原子%程度までのIn、Ga、Zn、Sn、Si、C u, Au, Ag, Pd, Pt, Pb, Cr, Co, O, S、Se、Ta、Nb、Vのうち少なくとも1種を含む 合金薄膜が挙げられる。あるいは、高速でのオーバーラ イトが可能な材料として、Sbm Tem 共晶点近傍のS 30 bTe合金を主成分とする、MSbTe (M=In. G a, Zn, Ge, Sn, Si, Cu, Au, Ag, P d, Pt, Pb, Cr, Co, O, S, Se, Ta, N b、Vのうち少なくとも1種) 合金薄膜が好ましい。 【0021】光記録層上には耐候性、高硬度、高滑性な どの性質を備えた透明中間層を設ける。中間層の材質は これら性質を考慮の上選ばれる。中間層として誘電体が 好ましく金属酸化物、窒化物、カルコゲン化物、炭化 物、フッ化物、およびその混合物などが用いられる。金 属酸化物としてはA12O3、Ta2O5、SiO2、Si O、TiO2等の金属酸化物単独またはこれらの混合 物、或いはA1-Ta-Oの複合酸化物等が挙げられ る。金属窒化物としては、窒化ケイ素、窒化アルミニウ ム等が挙げられる。

【0022】 ルルコゲン化物としては、ZnS、ZnS e等のカルコゲン化亜鉛、CdS、CdSe等のII−V 族化合物、La:Si、Ce:S等の希土類離化物、Ta Si、MgS、CaS等が挙げられる。カルコゲン化亜 鉛は化学的にも安定で、その中でも特にZnSは潜性も 低く最も好ました。これら影像性縁の形成方法として は、燕着やスパッタリングが挙げられるが、スパッタリングがより好ましい。滑性に優かた対質としては炭素 販、木素化カーボン膜、窒素化カーボン膜、下iC、S iC等の炭化膜、SiN、TiN等の窒化膜、SiO、 A1。O1、ZrO等の酸化物膜等によって構成され、通 常、スパック法等により形成される。より好ましくは、 炭素膜、木素化カーボン膜および窒素化カーボン膜である。

【0023]中間層は保護層および滑性層としての役割を有するが、これを複数層としてもよい。例えば記録層に接する場所を発性優別な変の高い保護層と、潤滑層に接する側に滑性に優れた滑性層を設けると、全体として両方に優れた性質を得ることができ、好ましい。光磁、完置線解に接する層としては、定化シリコン、SiO、Ta:O:などが好適に用いられる。相変化型記録解に接する層としては、ZnSと金属酸化物の混合物が好確に用いられる。

【0024】好ましくは、基板と配縁層との間に反射層を設ける。反射層としては液反射率の金属または合金が20 用いられ、例えばA1人名。Au、Cuで入れを主統分とする合金である。さらに、基板あるいは反射層と、配縁層との間に、光を干渉させ増幅させる目的や記燥層保護の目的等で透明中間を設けても良い。材質としては、上述した誘電体等が好ましく用いられる。これ等光記録媒体の最外層には潤滑利層を形成することができる。

【0025】獨清剤としては磁気ディスクに用いるものと同じでよいが、エステル結合を有するパーフルオロボ リエーテル、ジアルキルアミドカルボン酸、パークロロボリエーテル、ステアリン酸、ステアリン酸・パークロロボリエーテル、ステアリン酸、ステアリン酸ナトリウ内のどこにあってもよいが、末端にエステル結合の自管基を有すると分子中の可動部が長くなり潤滑性が得られ、場いためより変ましい。特に重領に一尺・F、〇一単位(但し、aは1~4の整数)を有し、末端にエステル結合の官能基を有するパーフルオロボリエーテルが好ましい。

【0026】 潤清剤の分子量は100~1000の範囲内が好ましか。分子量が低いと一般的に蒸気圧が高
40く、強布した後にわずかづつ増散し、時間と共に所望の膜厚から外れてしまう。逆に分子量が高い場合は、一般的に粘性が高く、所望の潤滑性が得られない時がある。また、これのを解除させる溶験としては例えばプロン系、アルコール系、炭化水素系、ケトン系、エーテル系、アルコール系、炭化水素系、ケトン系、エーテル系、アン表系、芳香族系等が用いられる。潤清剤をあるとが好ましい。この範囲外すなわち薄い場合は、所望の潤清性が得られないが、あまり厚くしても一定以上の潤清性は得られないが、あまり厚くしても一定以上の潤清性は得られないが、あまり厚くしても一定以上の潤清性は得られないが、あまり厚くしても一定以上の潤清性は得られないが、あまり厚くしても一定以上の潤清性は得られないが、あまり厚くしても一定以上の潤清性は得られないが、あまり厚くしても一定以上の潤清性は消息の多

【0027】このような情報配録媒体の製造において、 基板表面の清浄化あるいは研修、グラインディング、ボ リッシュ、テキスチャ加工等の処理を行った後のスクラ ブロール洗浄やジェット洗浄等に適用される。以下、図 1を用いて本祭明のディスタ基板洗浄装置及び洗浄方法 について説明する。図1は本発明に係るディスタ基板洗 冷装層のデスタ支持印度部の過去図からな

【0028】本発明洗浄装置の外部構造は従来装置と同 に構造であってよく、図1に示すように、ディスク基板 の外周機部を可動駆動ローラー2、可動駆動ローラー 10 3及び固定駆動ローラー4の3つのローラーにより挟持 されて、ディスク基板1 は該3つの駆動ローラーにより回転 力を与えられて回転し、図示しないスクラブロール等に より洗浄が行われる。

【0029】にれら3つの駆動ローラー2、3、4は、例えば図示しない駆動施から1つの駆動輪5と3本のベルト8、9、10もしくは首車を通じて一定速度で回転させる構造となっている。洗浄時は、3ローラーで回転させ、ディスタの受け入れ時、洗浄終了後の排出時は120一ラー参動部付も、7を図の上方に動かすことにより図の上部の2つの可動ローラー2、3が図の上方に移動し、ローラー4を移動させることなくディスク基板1の支持を解除する

[0030]下部ローラーは常時固定されている。勿論、1の同定ローラーを上部に配置し、2の可動ローラーを上部に配置し、2の可動ローラーを下部に配置しても良い。ディスク基板を3以上の原動ローラーで回転させるため、ディスク回転ムラの原因となるスリップが非常に起こりにくくなる。特に、スリップを起こしやすい500 г p m以上の高速回転で洗浄 30を行う場合に効果が大きい。

【0031】これにより、ディスク基板の回転ムラに起 因する、基板の洗浄不良発生を抑えることができる。好 ましくは上配ローラーのうち少なくとも1を固定駆動ロー ラーとする。また、これらローラーはディスクの流れ に対してディスクの前後ではなくディスク両側面に配置** * することが好ましい。つまり、ディスク基板を直立した 状態に支持し回転させながら洗浄を行う場合はディスク の上下に配置する。

【0032】これによって、ローラーがディスクの流れを妨げることがなく、ディスク受け入れ、回転洗浄、ディスク集け一連の工程でも2の可動ローラーをディスク側面から外すだけでよく、移動ラインが切断されることがない。それゆえ、簡単なラインでディスタ基板の洗浄を行うことができ、洗浄設備全体のコンパクト化が可能となる。

【0033】駆動ローラーは少なくとも3以上であれば よく、他にサポートローラーや駆動ローラーを配置して もよい、ディスク基板を洗浄するためのスクラブロール は、多私性のスクラブおを関而に有し、例えばスクラブ 材としては満水性で弾力性のある材料が使用され、発泡 ウレタン等の連続気泡性期報、ポリプロピンと、ナイロ ン等の合成繊維の線布、不識布等を用いることができ

[0034]

【発明の効果】本発明によれば、ディスク基板洗浄時の 基板の回転を安定させ、さらに高速回転での洗浄を可能 とし、洗浄力の向上及び洗浄時間の短縮を測ることがで きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の洗浄装置のディスク支持回転部の模式 図

【図2】従来の洗浄装置のディスク支持回転部の模式図 【符号の説明】

サポートローラー

1 ディスク基板 2、3 可動駆動ローラー 4 固定駆動ローラー 5 ローラー駆動軸 6、7 ローラー移動部材 8、9、10 ベルト 12、13 駆動ローラー

図2]

14

